

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成24年10月25日 (2012.10.25)

【公開番号】特開2010-109337(P2010-109337A)

【公開日】平成22年5月13日 (2010.5.13)

【年通号数】公開・登録公報2010-019

【出願番号】特願2009-218265(P2009-218265)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/82 (2006.01)

G 0 1 R 31/317 (2006.01)

H 0 1 L 21/822 (2006.01)

H 0 1 L 27/04 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/82 S

G 0 1 R 31/28 A

H 0 1 L 27/04 T

H 0 1 L 21/82 F

H 0 1 L 27/04 M

【手続補正書】

【提出日】平成24年9月7日 (2012.9.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

少なくとも第 1 及び第 2 の機能回路と、

制御回路と、

第 1 乃至第 3 の配線と、を有し、

前記第 1 の機能回路は、前記制御回路と電氣的に接続され、

前記第 2 の機能回路は、前記制御回路と電氣的に接続され、

前記第 1 の配線は、前記制御回路と電氣的に接続され、

前記第 2 の配線は、前記第 1 の機能回路と電氣的に接続され、

前記第 3 の配線は、前記第 2 の機能回路と電氣的に接続され、

前記第 1 の配線は、絶縁体を介して前記第 2 の配線の一端と重なる第 1 の領域と、前記絶縁体を介して前記第 3 の配線の一端と重なる第 2 の領域と、有する半導体装置の作製方法において、

前記第 1 及び前記第 2 の機能回路の動作を検査し、

前記検査によって前記第 1 の機能回路の動作が規格に則していないと判定された場合、

前記第 1 の領域と前記第 2 の配線の一端との間の前記絶縁体をレーザー照射することにより、前記第 1 の配線と前記第 2 の配線とを電氣的に接続させ、

前記検査によって前記第 2 の機能回路の動作が規格に則していないと判定された場合、

前記第 2 の領域と前記第 3 の配線の一端との間の前記絶縁体をレーザー照射することにより、前記第 1 の配線と前記第 2 の配線とを電氣的に接続させることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 2】

請求項 1 において、

前記第 1 の配線と前記第 2 の配線とを電氣的に接続させることにより前記第 1 の機能回路が動作しない状態となり、前記第 1 の配線と前記第 3 の配線とを電氣的に接続させることにより前記第 2 の機能回路が動作しない状態となることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 3】

少なくとも第 1 及び第 2 の機能回路と、
制御回路と、
第 1 乃至第 3 の配線と、を有し、
前記第 1 の機能回路は、前記制御回路と電氣的に接続され、
前記第 2 の機能回路は、前記制御回路と電氣的に接続され、
前記第 1 の配線は、前記制御回路と電氣的に接続され、
前記第 2 の配線は、前記第 1 の機能回路と電氣的に接続され、
前記第 3 の配線は、前記第 2 の機能回路と電氣的に接続され、
前記第 1 の配線は、絶縁体を介して前記第 2 の配線の一端と重なる第 1 の領域と、前記
絶縁体を介して前記第 3 の配線の一端と重なる第 2 の領域と、を有し、
前記絶縁体は、レーザーを用いて除去できる材料を含むことを特徴とする半導体装置。

【請求項 4】

少なくとも第 1 及び第 2 の機能回路と、
制御回路と、
第 1 乃至第 3 の配線と、を有し、
前記第 1 の機能回路は、前記制御回路と電氣的に接続され、
前記第 2 の機能回路は、前記制御回路と電氣的に接続され、
前記第 1 の配線は、前記制御回路と電氣的に接続され、
前記第 2 の配線は、前記第 1 の機能回路と電氣的に接続され、
前記第 3 の配線は、前記第 2 の機能回路と電氣的に接続され、
前記第 1 の配線は、絶縁体を介して前記第 2 の配線の一端と重なる第 1 の領域と、前記
絶縁体を介して前記第 3 の配線の一端と重なる第 2 の領域と、を有し、
前記絶縁体は、窒化シリコン又はポリイミドを含むことを特徴とする半導体装置。